



IFD

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Serial No.: 10/694,401

Confirmation No.: 9216

In re Application of:

Tomoyuki IDEHARA

Group Art Unit: 2818

Filed: October 28, 2003

Examiner:

For: PHASE CHANGE-TYPE MEMORY ELEMENT AND
PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

CLAIM FOR PRIORITY

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following country is hereby requested for the above-identified application and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

Japan 2002-317184 October 31, 2002

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. 119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,

PARKHURST & WENDEL, L.L.P.

Roger W. Parkhurst
Registration No. 25,177

August 9, 2004
Date

Attorney Docket No. DAIN:757
PARKHURST & WENDEL, L.L.P.
1421 Prince Street, Suite 210
Alexandria, Virginia 22314-2805
Telephone: (703) 739-0220

PLEASE ACCEPT THIS AS
AUTHORIZATION TO DEBIT
OR CREDIT FEES TO
DEP. ACCT. 16-0331
PARKHURST & WENDEL

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年10月31日
Date of Application:

出願番号 特願2002-317184
Application Number:

[ST. 10/C] : [JP2002-317184]

出願人 大日本印刷株式会社
Applicant(s):

2004年 6月21日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫

【書類名】 特許願

【整理番号】 D1-2002-17

【提出日】 平成14年10月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 27/10

H01L 45/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内

【氏名】 出原 知之

【特許出願人】

【識別番号】 000002897

【氏名又は名称】 大日本印刷株式会社

【代表者】 北島 義俊

【代理人】

【識別番号】 100095463

【弁理士】

【氏名又は名称】 米田 潤三

【電話番号】 03-3255-7888

【選任した代理人】

【識別番号】 100098006

【弁理士】

【氏名又は名称】 皿田 秀夫

【電話番号】 03-3255-7888

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 066213

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9717238

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 相変化型メモリ素子およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁層を介して配設された2以上の電極と、前記絶縁層と前記電極の少なくとも一部が露出している表出面と、少なくとも2つの前記電極に接触するように前記表出面上に設けられた相変化記録材料層と、を備えることを特徴とする相変化型メモリ素子。

【請求項2】 前記表出面は平面、多平面および曲面の少なくとも1つで構成されていることを特徴とする請求項1に記載の相変化型メモリ素子。

【請求項3】 前記相変化記録材料層は厚みが1～1000nmの範囲であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の相変化型メモリ素子。

【請求項4】 1個のメモリ領域を構成する一対の電極間の前記絶縁層の厚みが10～1000nmの範囲であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の相変化型メモリ素子。

【請求項5】 前記相変化記録材料層はカルゴゲナイトの少なくとも1種を含有することを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の相変化型メモリ素子。

【請求項6】 前記相変化記録材料層は有機材料からなることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の相変化型メモリ素子。

【請求項7】 前記表出面と前記相変化記録材料層との間にバリア層および／または熱制御層が存在することを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれかに記載の相変化型メモリ素子。

【請求項8】 2以上の電極を絶縁材料により離間させて配設する工程と、前記絶縁材料と前記電極の少なくとも一部が露出する表出面を形成する工程と、該表出面上に前記電極の少なくとも2つに接触する相変化記録材料層を形成する工程と、を有することを特徴とする相変化型メモリ素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は消去可能型不揮発性メモリ素子、特に相変化型メモリ素子と、その製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

【特許文献1】特開平5-21740号公報

【特許文献2】特開平4-45583号公報

【特許文献3】特開平4-45585号公報

電気的に書き換え可能であり、かつ、消去可能である相変化する材料、例えば、ほぼ非晶質（アモルファス）状態とほぼ結晶質状態との間、または、結晶質状態に維持されながら異なる抵抗状態の間で電気的にスイッチングできる材料を記録材料として使用した相変化型メモリ素子が特許文献1に開示されている。

【0003】

特許文献1に開示されている相変化型メモリ素子では、電極間に記録材料（相変化材料）が配設され、電極と記録材料の間に所定の大きさの開口を有する絶縁層が介在した構造となっている。そして、電極間にセットパルスを印加してオン状態とし、リセットパルスの印加によりオフ状態に戻される。しかし、電圧印加により記録材料に生じる電流バスの直径は2～3μmに達するため相変化領域の体積が大きく、オン状態からオフ状態に戻すリセットパルスとして大きな電流パルスが必要であるという問題があった。また、記録材料の相変化領域を除く部分は非晶質状態となっていることが必要であり、このため、相変化型メモリ素子を記録材料の結晶化温度以下で製造する必要があり、例えば、駆動回路を構成するトランジスタやダイオードの製造時の温度が制約を受けるという問題があった。

一方、特許文献2には、内径0.1～1.5μmのコンタクトホールを設けた絶縁層の一方の面に、コンタクトホール内を充填するように記録材料層を設け、この記録材料層と絶縁層を下部電極と上部電極で挟持した構造の相変化型メモリ素子が開示されている。また、特許文献3には、上下の電極間に記録材料を直径0.1～1.5μmの柱状に形成し、この記録材料の周囲に絶縁層を形成した構造の相変化型メモリ素子が開示されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、特許文献2、3に開示の相変化型メモリ素子では、オン状態からオフ状態に戻すためのリセットパルスの電流は比較的小さくなり、また、プロセス温度の制約もなくなるものの、内径0.1～1.5μmのコンタクトホールの形成や、直径0.1～1.5μmの柱状に記録材料を形成することは、高度な技術を要するため、歩留りが低いという問題があった。また、記録材料を充填するためのコンタクトホールの内径を小さくすること、あるいは、記録材料の直径を小さくすることは、製造技術上の限界があり、特許文献2、3に開示されるような構造の相変化型メモリ素子において集積度を向上させるには限界があった。

本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、オン状態からオフ状態に戻すためのリセットパルスの電流値が小さく、集積度の向上が可能であり、また、製造時のプロセス温度の制約がなく、製造が簡便な相変化型メモリ素子と、その製造方法を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】

このような目的を達成するために、本発明の相変化型メモリ素子は、絶縁層を介して配設された2以上の電極と、前記絶縁層と前記電極の少なくとも一部が露出している表出面と、少なくとも2つの前記電極に接触するように前記表出面上に設けられた相変化記録材料層と、を備えるような構成とした。

本発明の他の態様として、前記表出面は平面、多平面および曲面の少なくとも1つで構成されているような構成とした。

本発明の他の態様として、前記相変化記録材料層は厚みが1～1000nmの範囲であるような構成とした。

【0006】

本発明の他の態様として、1個のメモリ領域を構成する一対の電極間の前記絶縁層の厚みが10～1000nmの範囲であるような構成とした。

本発明の他の態様として、前記相変化記録材料層はカルゴゲナイトの少なくとも1種を含有するような構成、あるいは、前記相変化記録材料層は有機材料からなるような構成とした。

本発明の他の態様として、前記表出面と前記相変化記録材料層との間にバリア層および／または熱制御層が存在するような構成とした。

また、本発明の相変化型メモリ素子の製造方法は、2以上の電極を絶縁材料により離間させて配設する工程と、前記絶縁材料と前記電極の少なくとも一部が露出する表出面を形成する工程と、該表出面上に前記電極の少なくとも2つに接触する相変化記録材料層を形成する工程と、を有するような構成とした。

【0007】

【発明の実施の形態】

以下、本発明について図面を参照しながら説明する。

相変化型メモリ素子

図1は、本発明の相変化型メモリ素子の基本的構成を示す一例の平面図であり、図2は図1に示される相変化型メモリ素子のII-II線における縦断面図である。図1および図2において、相変化型メモリ素子1は、基板2とこの基板2の一方の面に配設された電極4、この電極4に絶縁層3を介して配設された電極5、この電極4と絶縁層3と電極5の積層体を覆うように形成されている絶縁層3'を備え、さらに、上記の電極4の端面4aと、絶縁層3の端面3aと、電極5の端面5aとが露出している平面である表出面7に相変化記録材料層8を備えている。表出面7に設けられた相変化記録材料層8は、絶縁層3の端面3aによって離間されている電極4の端面4aと電極5の端面5aに接触するものである。

【0008】

この相変化型メモリ素子1では、一対の電極4、5と相変化記録材料層8が1個のメモリ領域を構成する。そして、一対の電極4と電極5の間にセットパルスを印加すると、表出面7に沿った電流バスが相変化記録材料層8中に生じて相変化領域8aとなる。この相変化領域8aでは、ジュール熱が発生して非晶質状態から結晶質状態に相変化し、抵抗値が低下して相変化型メモリ素子1がオン状態となる。また、電極4と電極5の間にリセットパルスを印加すると、上記の相変化領域8aにジュール熱が発生し、その熱が周囲の相変化記録材料層8に奪われて急冷されて結晶質状態から非晶質状態に相変化して戻り、抵抗値が高くなつて相変化型メモリ素子1がオフ状態となる。このような相変化型メモリ素子1の読

み取りは、例えば、電極4にリードパルスを印加し、相変化領域8aのオン状態、オフ状態に対応して変化する電極5の出力を読み取ることで行うことができる。

【0009】

このように、本発明の相変化型メモリ素子1は、相変化記録材料層8中に生じる電流パスが表出面7に沿ったものとなり、オン状態とオフ状態との間を可逆的に変化する相変化領域8aの体積は小さいものである。したがって、オン状態からオフ状態に戻すためのリセットパルスの電流値は小さいものとなる。また、相変化記録材料層8の形成は、相変化型メモリ素子1の製造の最終工程となるため、それ以前のプロセス温度の制約はないものとなる。

【0010】

本発明の相変化型メモリ素子1を構成する基板2は、単結晶半導体基板、ガラス基板、シリコンウエハ、ポリカーボネート基板、アクリル基板、ポリエチレンテレフタレート基板、ポリプロピレン基板、フィルム等とすることができる。また、絶縁層3、3'は、酸化珪素(SiO_x)、アルミナ、ステアタイト、ポリイミド、ポリエチレン、ポリプロピレン、四フッ化エチレン、ポリ塩化ビニル、ガラス等の従来公知の絶縁材料を使用することができる。電極4と電極5を離間させるための絶縁層3の厚みT1は、10～1000nm、好ましくは10～300nmの範囲で設定することができる。絶縁層3の厚みが10nm未満であると、電極間の絶縁が不充分となったり、製造歩留りが低下し、また、絶縁層3の厚みが1000nmを超えると集積度の向上に支障を来すので好ましくない。

【0011】

また、相変化型メモリ素子1を構成する電極4、5は、Ni、Al、Au、Cu、Ag、Mo、Ti、W、Ta、Crおよびこれらの合金、あるいは、酸化インジウムスズ(ITO)、インジウムチタン(IT)、酸化亜鉛(ZnO)等の透明導電材料等の従来公知の導電材料を使用することができる。このような電極4、5の厚みT2は、10～1000nm、好ましくは10～300nmの範囲で設定することができる。また、電極4、5の幅Wは、0.05～15μm、好ましくは0.05～1.0μmの範囲で設定することができる。

【0012】

相変化型メモリ素子1を構成する相変化記録材料層8は、カルゴゲナイト、Te、Se、Ge、Sb、In、Ga、Bi、Ag、Pb、Sn、As、Si、P、Oから選択された合金および混合物等の無機材料、2-アミノ-4, 5-イミダゾールジカーボニトリル(AIDCN)、N-(3-ニトロベンジリデン)-P-フェニレンジアミン(NBPD)等の有機材料を使用することができる。図示例では、相変化記録材料層8が表出面7の全面に形成されているが、本発明はこれに限定されず、電極4の端面4aと電極5の端面5aに接触するものであれば制限はない。また、相変化記録材料層8の厚みは1～1000nm、好ましくは1～500nmの範囲で設定することができる。

【0013】

上述の例では、電極4の端面4aと、絶縁層3の端面3aと、電極5の端面5aとが露出している表出面7が平面であるが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、各端面4a、端面3a、端面5aがそれぞれ平面であり、かつ、これらが所定の角度で連続するような多平面形状、あるいは、表出面7が曲面であるような形状であってもよい。

また、図示例では、電極4、5が伸長する方向(図2に矢印aで示される方向)と表出面7とがなす角度が90°であるが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、図3に示されるように、電極4、5が伸長する方向(図3に矢印aで示される方向)と表出面7とがなす角度θが90°未満であってもよい。

【0014】

また、本発明では、上記の相変化型メモリ素子1において、バリア層および熱制御層の少なくとも一方を介して相変化記録材料層8を表出面7上に配設してもよい。バリア層と熱制御層の両層を形成する場合、表出面7側に熱制御層が位置するように積層することが好ましい。バリア層は相変化記録材料層8と電極4、5との導通を保つとともに、相変化記録材料層8への異物の拡散、もしくは、相変化記録材料の他層への拡散を防止する作用をなすものであり、例えば、Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W、B、C、N、O、Al、Si、P、S、Niおよびこれらの合金、あるいは、これらの組み合わせからなる材料

で形成することができる。また、熱制御層は発生した熱の放冷を制御する作用をなすものであり、C、F、O、N、Si、Hf、Al₂O₃およびこれらの合金、あるいは、これらの組み合わせからなる材料で形成することができる。

【0015】

本発明の相変化型メモリ素子は、基板を備えないものであってもよい。図4は、このような相変化型メモリ素子の一例を示す斜視図である。図4において、相変化型メモリ素子11は、絶縁層13を介して対向するように配設された1組の電極14、15と、この絶縁層13と電極14、15との積層体を封止するようにならって形成されている絶縁体16を備え、さらに、上記の絶縁層13の端面13aと、電極14の端面14aと、電極15の端面15aとが露出している平面である表出面17に相変化記録材料層18を備えている。尚、図示例では、相変化記録材料層18は仮想線（2点鎖線）で示されており、表出面17の全面に設けられているが、この相変化記録材料層18は、絶縁層13の端面13aによって離間されている電極14、15の端面14a、15aに接触するものであればよく、配設位置、大きさ等には特に制限はない。

【0016】

上述の例では説明を容易するために1組の電極と1つの相変化記録材料層で構成される1個のメモリ領域を示しているが、本発明の相変化型メモリ素子は複数のメモリ領域を備えてもよいことは勿論である。図5は、本発明の相変化型メモリ素子の他の例を示す斜視図であり、相変化型メモリ素子21は、絶縁層23と、この絶縁層23のほぼ中央に形成された凹部26とを備え、凹部26の各側壁面は複数の電極24、25の端面が露出した表出面27を構成している。各電極24と電極25と間には絶縁層23が介在しており、表出面27上には、図示されていない相変化記録材料層を備えている。これにより、相変化型メモリ素子21では、凹部26内に複数のメモリ領域が形成されている。また、図6は、本発明の相変化型メモリ素子の他の例を示す斜視図であり、相変化型メモリ素子31は、絶縁層33と、この絶縁層33の各側壁面に端部が露出している複数の電極34、35を備えている。各電極34と電極35と間には絶縁層33が介在しており、この絶縁層33の各側壁面が表出面37を構成し、図示されていない相

変化記録材料層が表出面37上に形成されている。これにより、相変化型メモリ素子31では、絶縁層33の側壁面に複数のメモリ領域が形成されている。

【0017】

上述のように絶縁層によって離間された電極が複数組存在する場合、電極を所定の規則性をもって配置することができる。図7および図8はこのような電極の配置例を示すものであり、図7では、絶縁層43に電極44、45がそれぞれ格子型となるように配置されている表出面47が示されている。また、図8では、絶縁層43に電極44、45がそれぞれ市松型となるように配置されている表出面47が示されている。図8に示される例では、1組の電極を構成する電極44と電極45（図中に鎖線で囲んだ1組の電極）の距離が、各電極のコーナー部44' と45'との間で著しく小さいものとなり、電界強度を大きくすることができ、リセットパルスの電流をより少ないものとすることができます。

【0018】

図9は、本発明の相変化型メモリ素子の他の例を示す斜視図である。図9において、相変化型メモリ素子51は、3つの絶縁層53a、53b、53cが端部側の上面53a'、53b'、53c'を露出させて階段形状となるように積層され、各絶縁層の露出している上面53a'、53b'、53c'には、それぞれ所定の間隔で配設されている電極54a、54b、54cが露出している。そして、電極54aが露出している絶縁層53aの上面53a' と、絶縁層53bの端面53b" と、電極54bが露出している絶縁層53bの上面53b' の3つの面が1つの表出面57aを構成し、この表出面57aに電極54aと54bを覆うように相変化記録材料層58a（図示例では鎖線で示してある）が設けられている。同様に、電極54bが露出している絶縁層53bの上面53b' と、絶縁層53cの端面53c" と、電極54cが露出している絶縁層53cの上面53c' の3つの面が1つの表出面57bを構成し、この表出面57bに電極54bと54cを覆うように相変化記録材料層58b（図示例では鎖線で示してある）が設けられている。尚、絶縁層の層数は図示例では3層であるが、これに限定されるものではない。

【0019】

この相変化型メモリ素子51では、一対の電極54a、54bと相変化記録材料層58aが1個のメモリ領域を構成し、一対の電極54b、54cと相変化記録材料層58bが1個のメモリ領域を構成することにより、複数のメモリ領域（図示例では8個）を備えるものとなっている。そして、一対の電極54aと電極54bの間に、あるいは、一対の電極54bと電極54cの間にセットパルスを印加すると、相変化記録材料層58aあるいは58b中に、表出面57a、57bに沿った電流バスが生じ相変化領域となり、非晶質状態から結晶質状態に相変化し、抵抗値が低下してオン状態となる。また、一対の電極54aと電極54bの間に、あるいは、一対の電極54bと電極54cの間にリセットパルスを印加すると、相変化記録材料層58aあるいは58b中の相変化領域が結晶質状態から非晶質状態に相変化して戻り、抵抗値が高くなつてオフ状態となる。

【0020】

また、図10は、本発明の相変化型メモリ素子の他の例を示す斜視図である。図10において、相変化型メモリ素子61は、3つの絶縁層63a、63b、63cが端部側の上面63a'、63b'、63c'を露出させて階段形状となるように積層されている。絶縁層63aの上面63a'には、所定の間隔で複数組配設されている一対の電極64a、65aが露出している。同様に、絶縁層63bの上面63b'には電極64b、65bが露出しており、絶縁層63cの上面63c'には電極64c、65cが露出している。そして、電極64a、65aが露出している絶縁層63aの上面63a'が1つの表出面67aを構成し、この表出面67aに電極64a、65aを覆うように相変化記録材料層68a（図示例では鎖線で示してある）が設けられている。同様に、電極64b、65bが露出している絶縁層63bの上面63b'が1つの表出面67bを構成し、この表出面67bに電極64b、65bを覆うように相変化記録材料層68b（図示例では鎖線で示してある）が設けられている。また、電極64c、65cが露出している絶縁層63cの上面63c'が1つの表出面67cを構成し、この表出面67cに電極64c、65cを覆うように相変化記録材料層68c（図示例では鎖線で示してある）が設けられている。尚、絶縁層の層数は図示例では3層であるが、これに限定されるものではない。

【0021】

この相変化型メモリ素子61では、一対の電極64a、65aと相変化記録材料層68a、一対の電極64b、65bと相変化記録材料層68b、一対の電極64c、65cと相変化記録材料層68cがそれぞれ1個のメモリ領域を構成することにより、複数のメモリ領域（図示例では6個）を備えるものとなっている。そして、例えば、一対の電極64aと電極65aの間にセットパルスを印加すると、相変化記録材料層68a中に、表出面67aに沿った電流パスが生じ相変化領域となり、非晶質状態から結晶質状態に相変化し、抵抗値が低下してオン状態となる。また、一対の電極64aと電極65aの間にリセットパルスを印加すると、相変化記録材料層68a中の相変化領域が結晶質状態から非晶質状態に相変化して戻り、抵抗値が高くなってオフ状態となる。

【0022】

また、本発明の相変化型メモリ素子は、絶縁層で離間された一対の電極と相変化記録材料層からなる個々のメモリ領域を電気的に分離する集積回路手段を備えるものであってもよい。このような集積回路手段は、例えば、トランジスタ、ダイオード等の公知の素子を備えるものとすることができます。図11は、ダイオードを備えた集積回路手段に9個のメモリ領域を接続するための各メモリ領域から伸長する電極の構成例を示す斜視図である。図11に示されるように、相変化型メモリ素子71は、基板72と、この基板72上に配設された第1層目の3本の電極74aと、第2層目の3本の電極75aと、第3層目の3本の電極74bと、第4層目の3本の電極75bと、第5層目の3本の電極74cと、第6層目の3本の電極75cと、各電極間に介在する絶縁層73とを備えている。そして、上記の6層、計18本の電極の端面と絶縁層の端面が露出している表出面77に相変化記録材料層（図示せず）が形成されている。

【0023】

上記の相変化型メモリ素子71では、第1層目の3本の電極74aは基板72に形成された電極72aの所定位置に配設された3個のダイオード（図示せず）に接続され、第3層目の3本の電極74bは基板72に形成された電極72bの所定位置に配設された3個のダイオード（図示せず）に接続され、第5層目の3

本の電極74cは基板72に形成された電極72cの所定位置に配設された3個のダイオード（図示せず）に接続されている。

また、相変化型メモリ素子71では、第2層目の3本の電極75aと第6層目の3本の電極75cは絶縁層73内を絶縁層側壁面73aまで引き出され、基板72上の端子部75'に接続されている。また、第4層目の3本の電極75bも絶縁層73内を絶縁層側壁面73aまで引き出され、基板72上の端子部75"に接続されている。

【0024】

上述の6層の電極を、図12～14を参照して更に詳しく説明する。

図12は第1層目の3本の電極74aと第2層目の3本の電極75aの配設状態を示す斜視図である。図12において、第1層目の3本の電極74aは基板72に形成された電極72aの所定位置に配設された3個のダイオード76aに接続するように伸長されている。また、絶縁層73（一点鎖線で示されている）を介して第1層目の3本の電極74a上に配設されている第2層目の3本の電極75aは、絶縁層側壁面73a方向に引き出され、絶縁層側壁面73aを、基板72上の端子部75'に接続するように伸長されている。

【0025】

また、図13は第3層目の3本の電極74bと第4層目の3本の電極75bの配設状態を示す斜視図である。図13において、第3層目の3本の電極74bは、第2層目の3本の電極75aを覆うように形成された絶縁層73上を絶縁層後壁面73b方向に伸長され、絶縁層後壁面73bを、基板72に形成された電極72bの所定位置に配設された3個のダイオード76bに接続するように伸長されている。また、絶縁層73（一点鎖線で示されている）を介して第3層目の3本の電極74b上に配設されている第4層目の3本の電極75bは、絶縁層側壁面73a方向に引き出され、絶縁層側壁面73aを、基板72上の端子部75"に接続するように伸長されている。尚、3個の端子部75"は上記の3個の端子部75'と共にしてもよい。

【0026】

また、図14は第5層目の3本の電極74cと第6層目の3本の電極75cの

配設状態を示す斜視図である。図14において、第5層目の3本の電極74cは、第4層目の3本の電極75bを覆うように形成された絶縁層73上を絶縁層後壁面73b方向に伸長され、絶縁層後壁面73bを、基板72に形成された電極72cの所定位置に配設された3個のダイオード76cに接続するように伸長されている。また、絶縁層73（一点鎖線で示されている）を介して第5層目の3本の電極74c上に配設されている第6層目の3本の電極75cは、絶縁層側壁面73a方向に引き出され、絶縁層側壁面73aを、第2層目の3本の電極75aとともに基板72上の端子部75'に接続するように伸長されている。

これにより、第1層目の3本の電極74aの各端面と第2層目の3本の電極75aの各端面から3個のメモリ領域A1, A2, A3（図中に鎖線で囲まれる領域）が構成される。同様に、第3層目の3本の電極74bの各端面と第4層目の3本の電極75bの各端面から3個のメモリ領域B1, B2, B3（図中に鎖線で囲まれる領域）が構成され、第5層目の3本の電極74cの各端面と第6層目の3本の電極75cの各端面から3個のメモリ領域C1, C2, C3（図中に鎖線で囲まれる領域）が構成される。

【0027】

また、上述の例では、第2層目の3本の電極75aと第6層目の3本の電極75cが接続されている基板72上の端子部75'と、第4層目の3本の電極75bが接続されている基板72上の端子部75"とが電気的に独立しているので、メモリ領域の変更が可能である。すなわち、第2層目の3本の電極75aの各端面と第3層目の3本の電極74bの各端面から3個のメモリ領域を構成することができ、第4層目の3本の電極75bの各端面と第5層目の3本の電極74cの各端面から3個のメモリ領域を構成することができる。

本発明の相変化型メモリ素子は、外部環境の影響が及ぶのを防止するために、相変化記録材料層や露出している電極等を覆うように封止してもよい。封止部材としては、エポキシ系、シリコン系等の封止部材を使用することができる。

【0028】

相変化型メモリ素子の製造方法

次に、本発明の相変化型メモリ素子の製造方法について、上述の図1および図

に示される相変化型メモリ素子を例として説明する。

図15および図16は、本発明の相変化型メモリ素子の製造方法を説明するための工程図である。本発明では、まず、単結晶半導体基板、ガラス基板等の基板2上にNi、Al、Au等の導電材料を使用して導電層を形成し、この導電層をフォトグラフィー法等によりパターニングして電極層4を形成する（図15（A））。

【0029】

次いで、電極層4を覆うように基板2上に酸化珪素（SiO_x）、アルミナ、ポリイミド等の絶縁層3を積層する（図15（B））。絶縁層3の形成は、気相成長法、液相成長法等の化学的方法や、コーティング法、真空蒸着法、スパッタリング法等の物理的方法等により行うことができる。さらに、上記の絶縁層3上にNi、Al、Au等の導電材料を使用して導電層を形成し、この導電層をフォトグラフィー法等によりパターニングして電極層5を形成する（図15（C））。これにより、電極4と電極5が絶縁層3により離間されて配設される。

次に、電極層5を覆うように絶縁層3上に酸化珪素（SiO_x）、アルミナ、ポリイミド等の絶縁層3'を積層する（図16（A））。その後、電極4、5の伸長方向（図16（A）に矢印aで示される方向）に対して垂直に絶縁層3の端面3a、電極4の端面4a、および、電極5の端面5aが露出する表出面を形成する（図16（B））。この表出面7の形成は、エッチング、ワイヤーカッター等の機械的な切断や破断、マスキングイオンビームによる削り出し等により行うことができる。

【0030】

次いで、表出面7に相変化記録材料層8を形成する（図16（C））。相変化記録材料層8の形成は、コーティング法、真空蒸着法、スパッタリング法、プラズマCVD法、イオンプレーティング法等により行うことができる。形成する相変化記録材料層8の厚みは1～1000nm、好ましくは1～500nmの範囲とすることができます、本発明では、相変化記録材料層8の薄膜化、および、厚み制御が容易である。

上述のような本発明の製造方法は、電極4、5間の距離を決定する絶縁層3の

厚みをナノオーダーで制御できる。このため、従来の相変化型メモリ素子に比べてメモリ領域の集積度を高くすることができる。また、コンタクトホールの形成工程や柱状の相変化記録材料の形成工程が不要であり、製造が簡便である。

【0031】

【実施例】

次に、実施例を示して本発明を更に詳細に説明する。

[実施例1]

ガラス基板上にスパッタリング法によりNiの導電層を形成し、この導電層をフォトグラフィー法によりパターニングして厚み200nm、幅1.0μmのストライプ状の電極層を形成した。次に、この電極層を覆うようにガラス基板上にSiO₂からなる絶縁層（電極層上の厚み200nm）をプラズマCVD法により形成した。その後、この絶縁層3上にスパッタリング法によりNiの導電層を形成し、この導電層をフォトグラフィー法によりパターニングして厚み200nm、幅1.0μmのストライプ状の電極層を上記の電極層に対して絶縁層を介して対向するように形成した。これにより、厚み200nmの2つのストライプ状の電極層が厚み200nmの絶縁層により離間された積層構造を形成した。

【0032】

次に、電極層を覆うように絶縁層上にSiO₂からなる絶縁層（厚み0.2μm）をプラズマCVD法により形成した。

次いで、上記のストライプ状の電極の伸長方向に対し垂直な面でワイヤーカッターによりガラス基板、電極層、絶縁層を切断し、断面を研磨して電極の端面が露出する表出面を形成した。

次に、この表出面上にスパッタリング法によりカルコゲナイト（TeSb）合金の薄膜を成膜して、相変化記録材料層（厚み200nm）を形成し、相変化型メモリ素子を作製した。

【0033】

上述のように作製した相変化型メモリ素子について、書き込み、読み取り、消去、読み取りを行った。すなわち、電極間にセットパルス電流（1.0mA）を印加してオン状態とした後にリードパルス電流（0.01mA）を印加して読み

取りを行い、次いで、電極間にリセットパルス電流（5. 0 mA）を印加してオン状態とした後にリードパルス電流（0. 01 mA）を印加して読み取りを行うことを1回の記録とし、この記録を30回繰り返し行った。その結果、オン状態での読み取り時の抵抗値の平均は約450Ωであり、オフ状態での読み取り時の抵抗値の平均は約1800Ωであった。このことから、本発明の相変化型メモリ素子は、低いリセットパルス電流であっても確実に機能することが確認された。

【0034】

[実施例2]

2つのストライプ状の電極層の厚みを50 nm、幅を0. 5 μmとし、カルコゲナイト（T e S b）合金の薄膜からなる相変化記録材料層の厚みを10 nmとした他は実施例1と同様にして相変化型メモリ素子を作製した。

上述のように作製した相変化型メモリ素子について、実施例1と同様に書き込み、読み取り、消去、読み取りを行った結果、オン状態での読み取り時の抵抗値の平均は約200Ωであり、オフ状態での読み取り時の抵抗値の平均は約800Ωであった。このことから、本発明の相変化型メモリ素子は、低いリセットパルス電流であっても確実に機能することが確認された。

【0035】

【発明の効果】

以上詳述したように、本発明によれば絶縁層と電極が露出している表出面に少なくとも2つの電極に接触するように相変化記録材料層が設けられているので、相変化記録材料層中の電流パスは上記表出面に沿ったものとなり、オン状態とオフ状態との間を可逆的に変化する相変化領域の体積は小さく、したがって、オン状態からオフ状態に戻すためのリセットパルスの電流値が小さいものとなり、かつ、相変化記録材料層の上記の相変化領域を除く部分は、非晶状態と結晶状態のいずれでもよいので、製造時のプロセス温度の制約がなく、また、電極間距離を決定する絶縁層の厚みはナノオーダーで制御できるため、従来の相変化型メモリ素子に比べて集積度が大幅に向上し、さらに、コンタクトホールや柱状の相変化記録材料を用いないので、製造が簡便であるという効果が奏される。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の相変化型メモリ素子の基本的構成を示す一例の平面図である。

【図2】

図1に示される相変化型メモリ素子のII-II線における縦断面図である。

【図3】

本発明の相変化型メモリ素子の他の例を示す斜視図である。

【図4】

本発明の相変化型メモリ素子の他の例を示す斜視図である。

【図5】

本発明の相変化型メモリ素子の他の例を示す斜視図である。

【図6】

本発明の相変化型メモリ素子の他の例を示す斜視図である。

【図7】

本発明の相変化型メモリ素子の表出面における電極の配置を示す図である。

【図8】

本発明の相変化型メモリ素子の表出面における電極の配置を示す図である。

【図9】

本発明の相変化型メモリ素子の他の例を示す斜視図である。

【図10】

本発明の相変化型メモリ素子の他の例を示す斜視図である。

【図11】

本発明の相変化型メモリ素子においてダイオードを備えた集積回路手段に9個のメモリ領域を接続するための各メモリ領域から伸長する電極の構成例を示す斜視図である。

【図12】

図11に示される相変化型メモリ素子の第1層目の3本の電極と第2層目の3本の電極の配設状態を示す斜視図である。

【図13】

図11に示される相変化型メモリ素子の第3層目の3本の電極と第4層目の3

本の電極の配設状態を示す斜視図である。

【図14】

図11に示される相変化型メモリ素子の第5層目の3本の電極と第6層目の3本の電極の配設状態を示す斜視図である。

【図15】

本発明の相変化型メモリ素子の製造方法を説明するための工程図である。

【図16】

本発明の相変化型メモリ素子の製造方法を説明するための工程図である。

【符号の説明】

1, 11, 21, 31, 51, 61, 71…相変化型メモリ素子

2…基板

3, 13, 23, 33, 43, 53a, 53b, 53c, 63a, 63b, 63c, 73…絶縁層

4, 5, 14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45, 54a, 54b, 54c, 64a, 65a, 64b, 65b, 64c, 65c, 74a, 75a, 74b, 75b, 74c, 75c…電極

7, 17, 27, 37, 47, 57a, 57b, 67a, 67b, 67c, 77…表面

8, 18, 58a, 58b, 68a, 68b, 68c…相変化記録材料層

72a, 72b, 72c…電極

75', 75"…端子部

76a, 76b, 76c…ダイオード

【書類名】

図面

【図1】

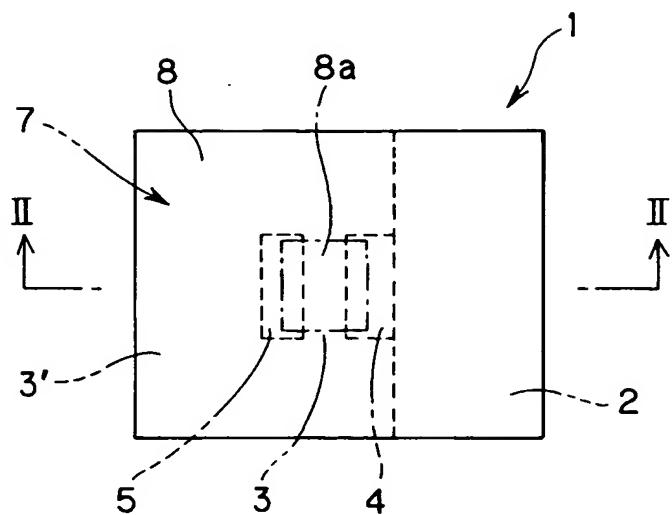


FIG. 1

【図2】

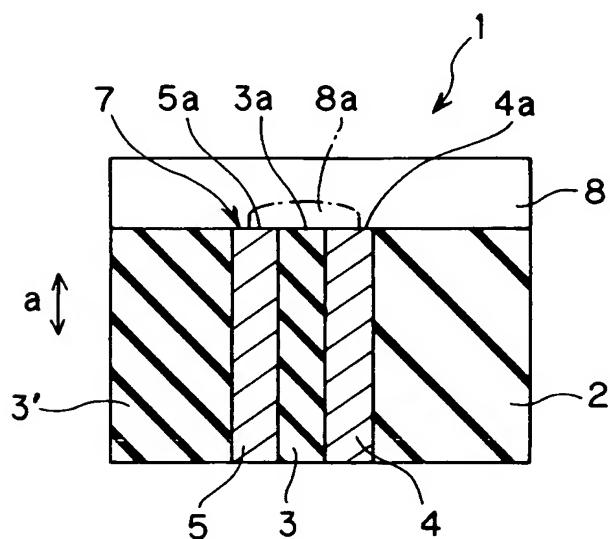


FIG. 2

【図3】

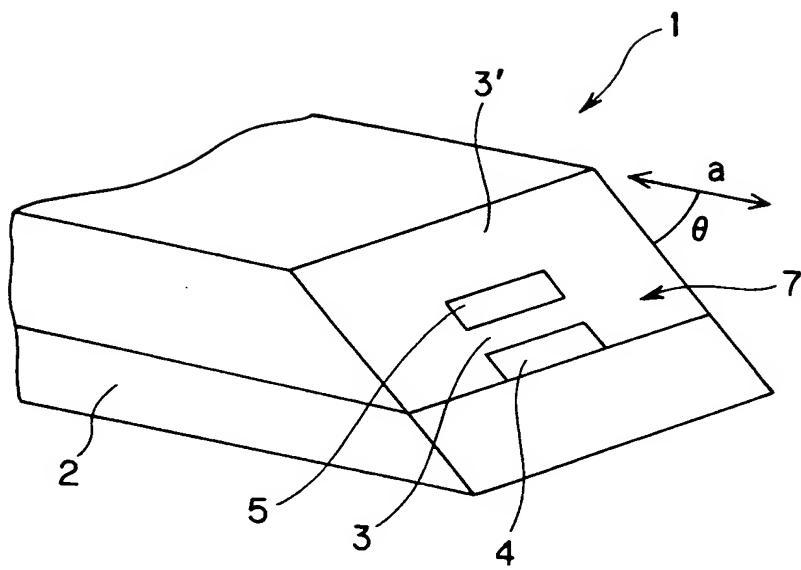


FIG. 3

【図4】

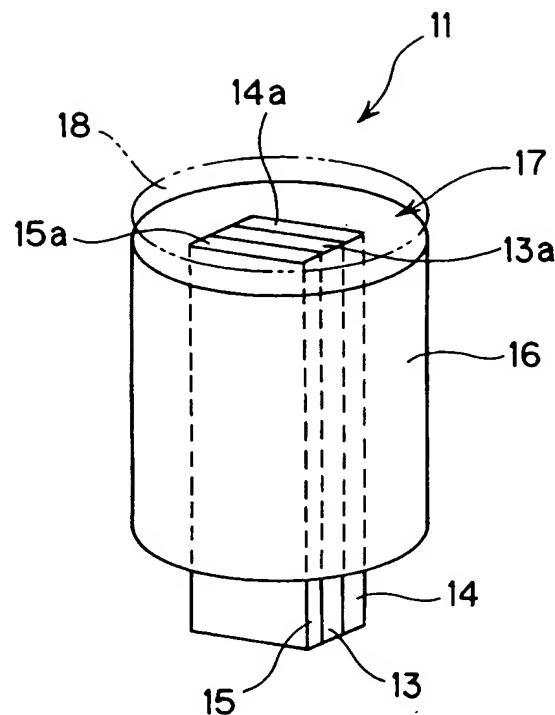


FIG. 4

【図5】

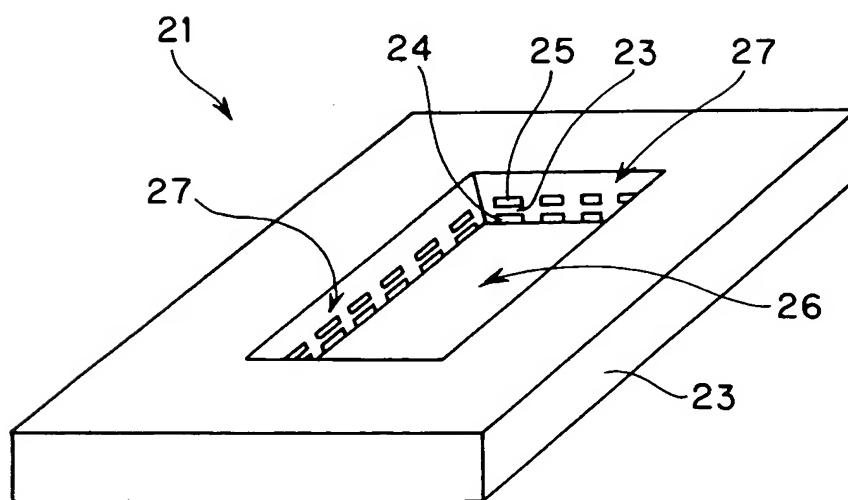


FIG. 5

【図6】

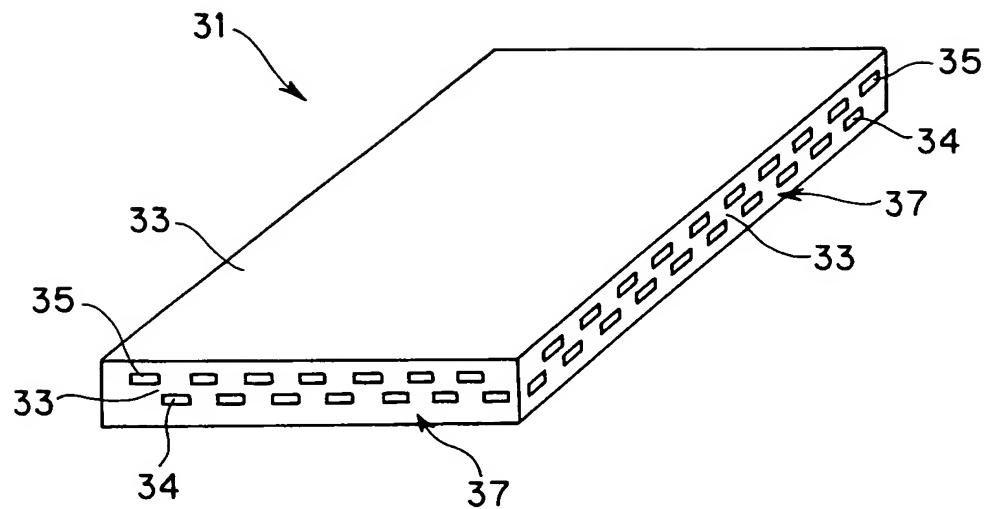


FIG. 6

【図7】

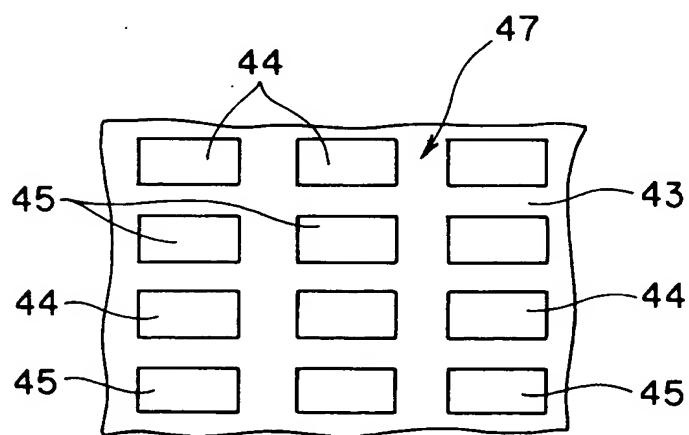


FIG. 7

【図8】

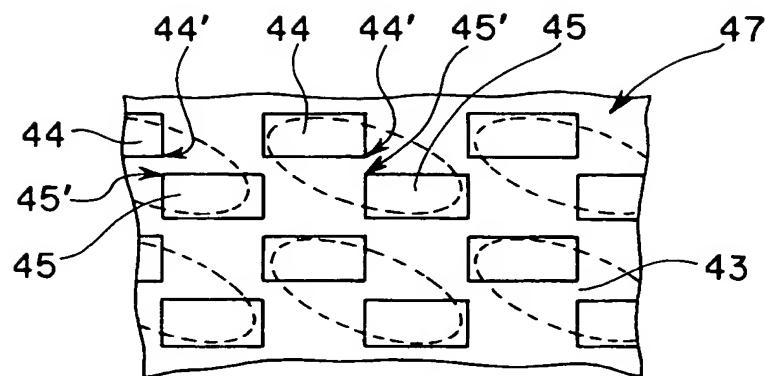


FIG. 8

【図9】

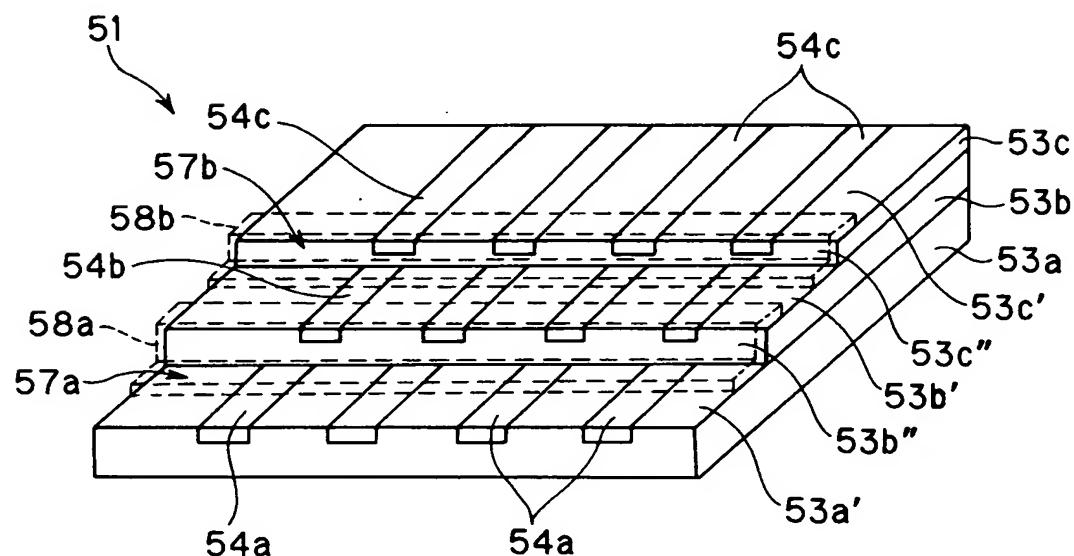


FIG. 9

【図10】

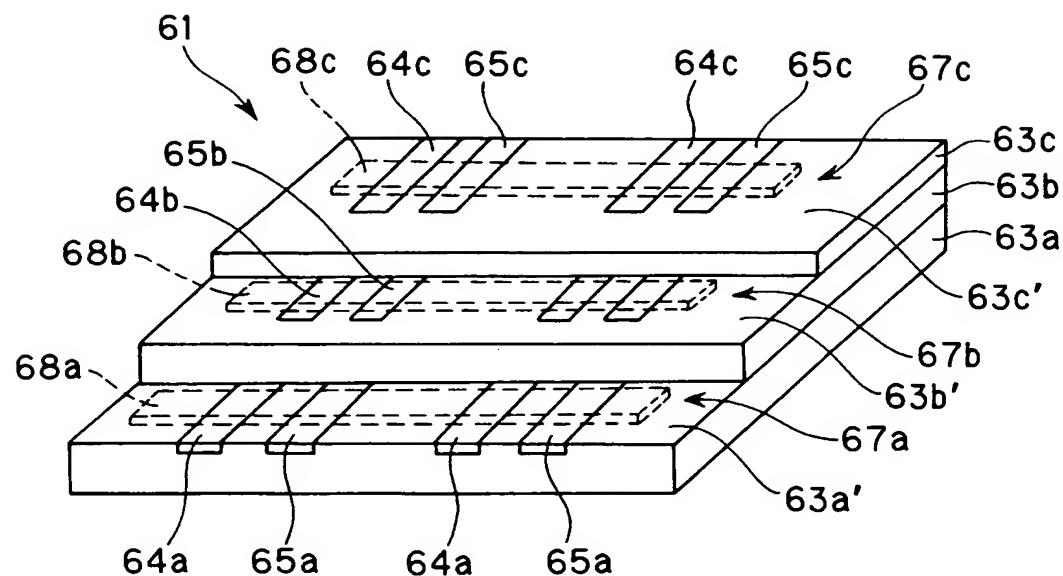


FIG. 10

【図11】

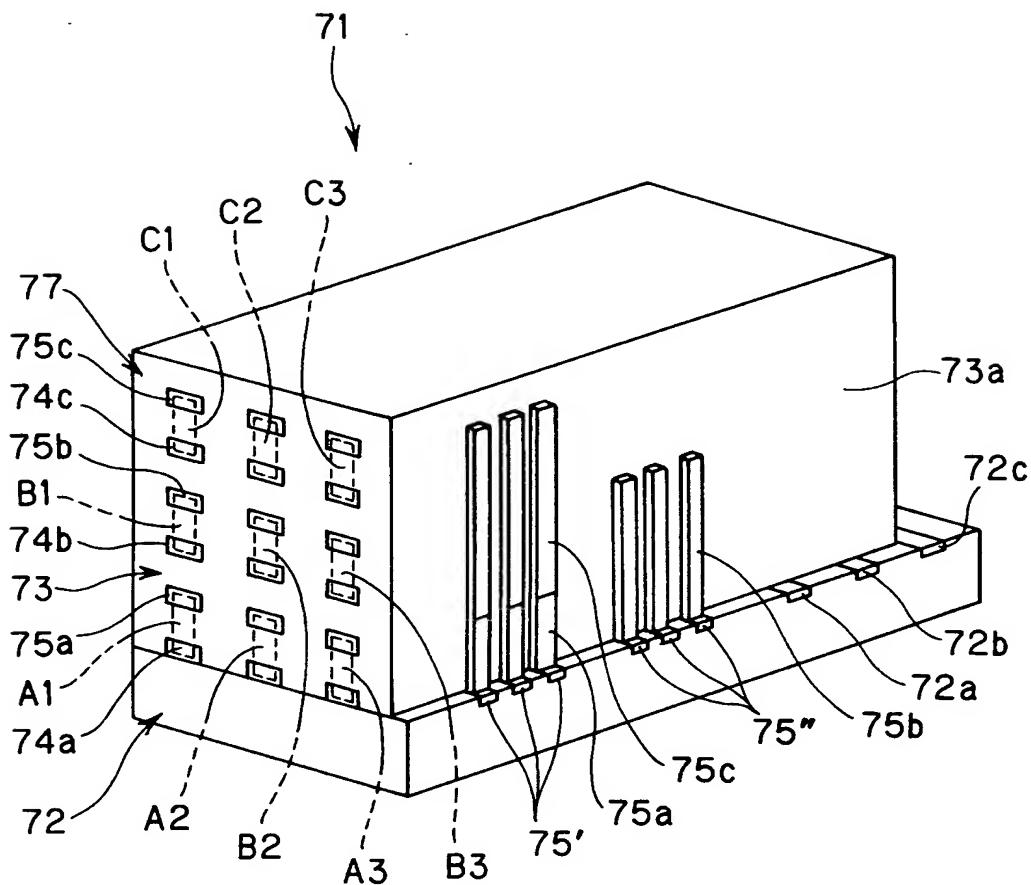


FIG. 11

【図12】

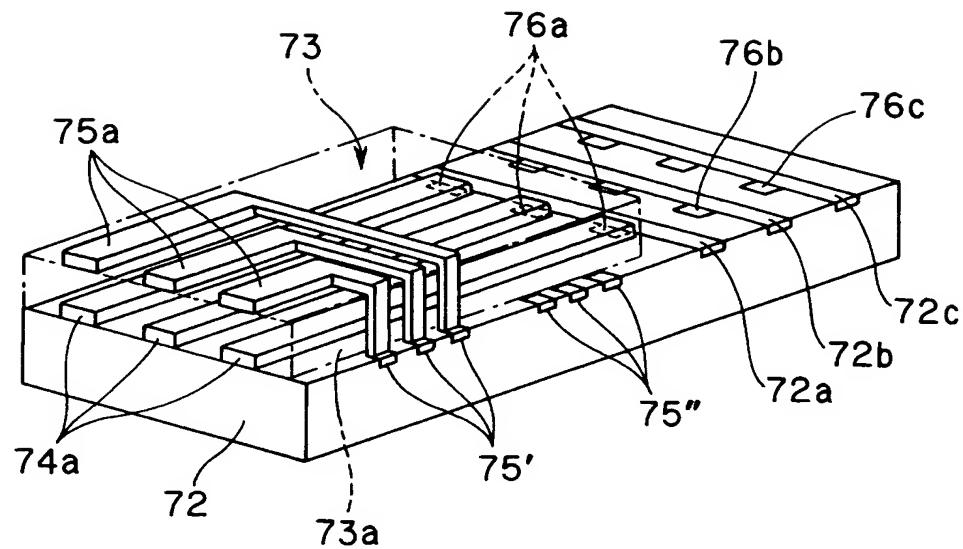


FIG. 12

【図13】

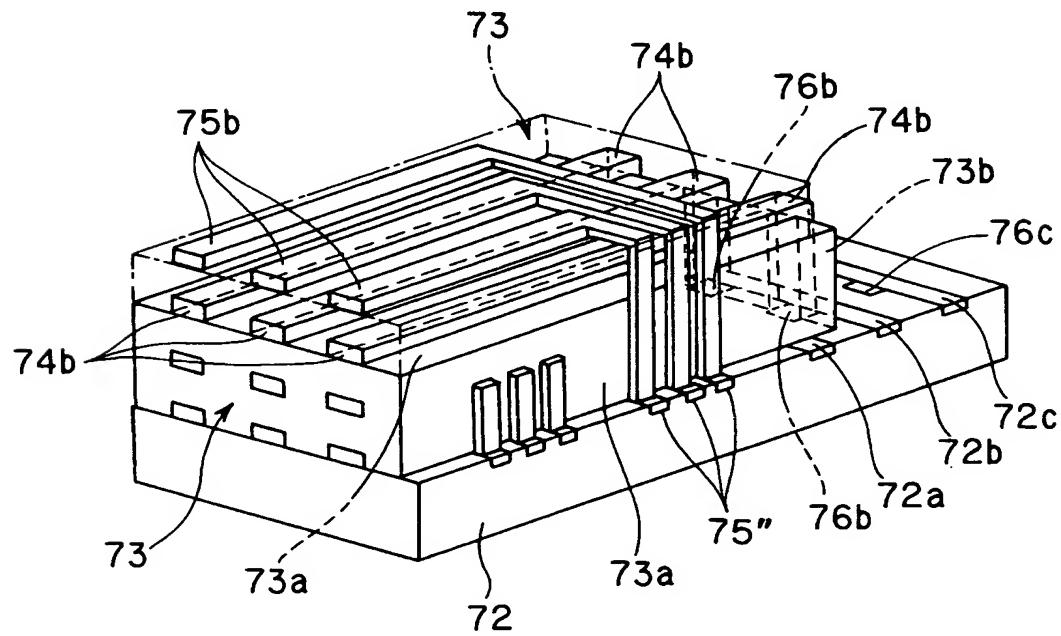


FIG. 13

【図14】

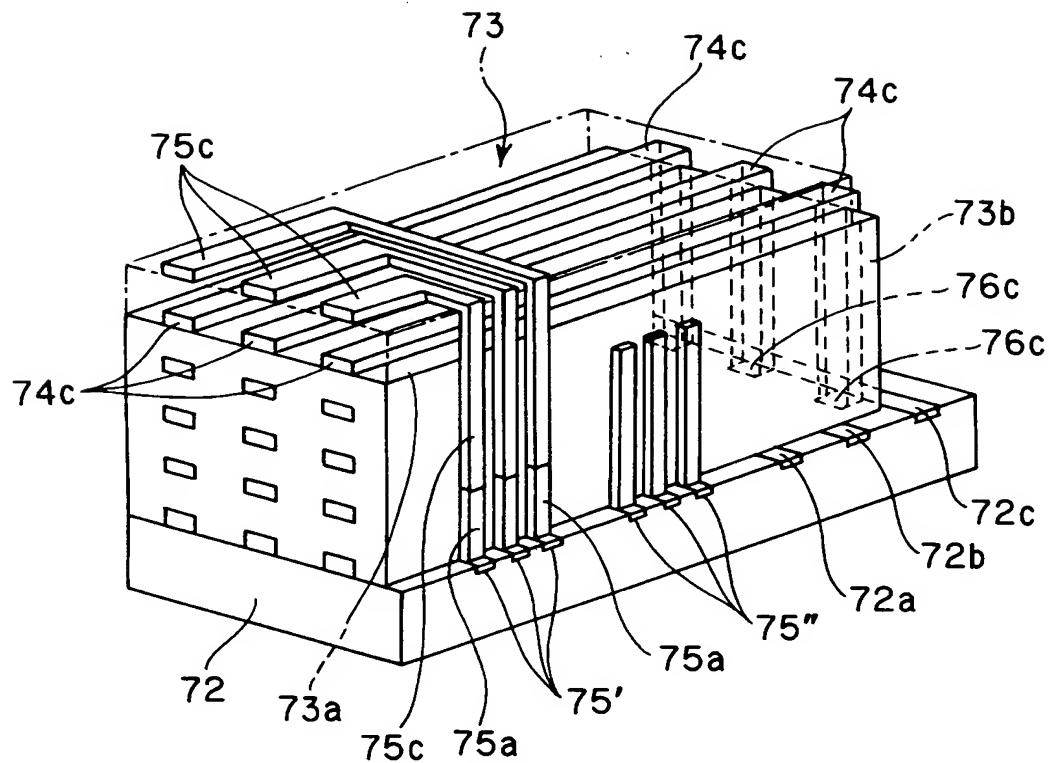


FIG. 14

【図15】

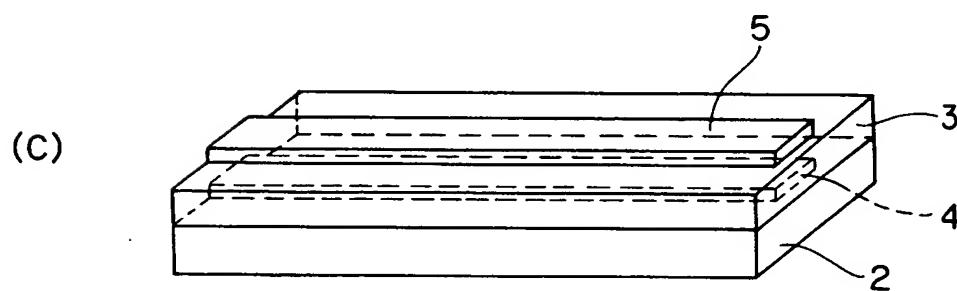
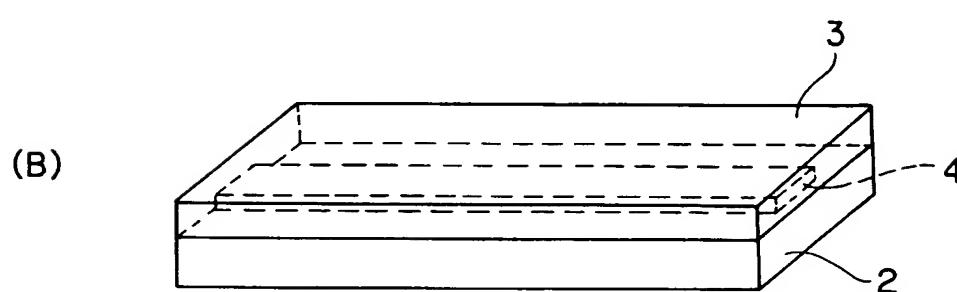
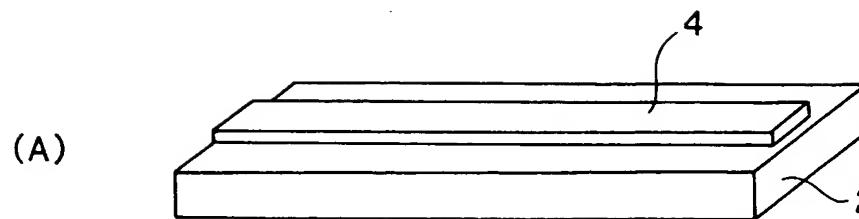


FIG. 15

【図16】

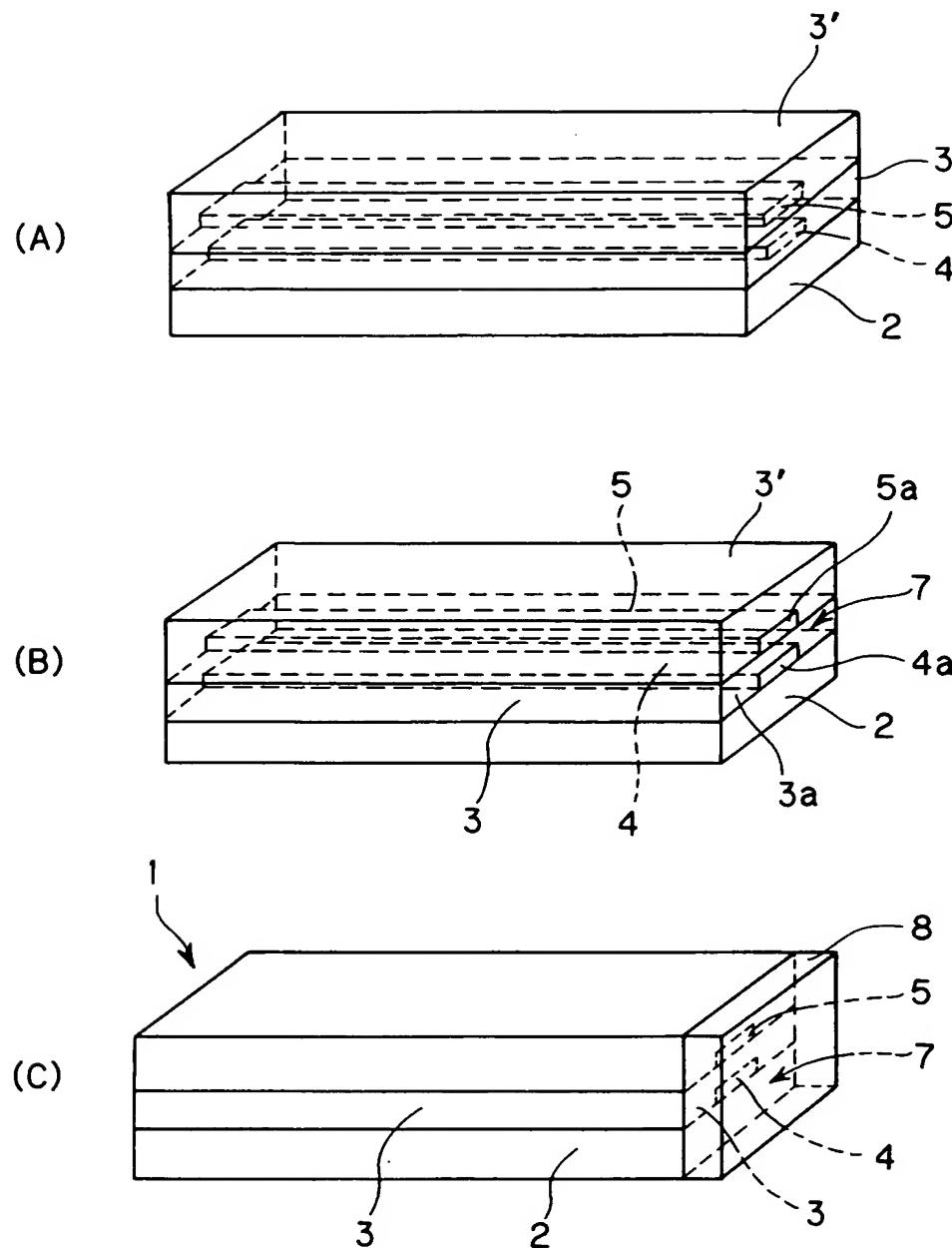


FIG. 16

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 オン状態からオフ状態に戻すためのリセットパルスの電流値が小さく、集積度の向上が可能であり、また、製造時のプロセス温度の制約がなく、製造が簡便な相変化型メモリ素子と、その製造方法を提供する。

【解決手段】 相変化型メモリ素子を、絶縁層を介して配設された2以上の電極と、絶縁層と電極の少なくとも一部が露出している表出面と、少なくとも2つの電極に接触するように表出面上に設けられた相変化記録材料層と、を備えるものとし、この相変化型メモリ素子の製造方法は、2以上の電極を絶縁材料により離間させて配設する工程と、絶縁材料と電極の少なくとも一部が露出する表出面を形成する工程と、この表出面上に電極の少なくとも2つに接触する相変化記録材料層を形成する工程と、を有するものとした。

【選択図】 図1

特願 2002-317184

出願人履歴情報

識別番号 [000002897]

1. 変更年月日 1990年 8月27日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
氏名 大日本印刷株式会社